

765IE10-1Н, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

765IE10 микросхемы полупроводниковой:

765IE10-1Н — интегральная микросхема артикул согласно ГОСТ микросхемы бескорпусные используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения и предназначена микросхема интегральная бескорпусная для работы в качестве два четырехразрядных счетчика. Применяется в качестве элементов составных интегральных чипов, микрочипов, блоков и аппаратуры, создающих герметичность и защищенность диодов СВЧ от влияния высокого уровня влажности, солей пыли, плесени, изморози и водяных осадков и перепадов давления. Модель прибора указывается на индивидуальной таре. Климатическое исполнение микросхем УХЛ и соответствует техническим условиям ТУ. Микросхема 2) соответствует техническим условиям БКО.347.151ТУ3. Микросхема 4) соответствует техническим условиям БКО.347.151ТУ3 и РМ 11091.926-81.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 765IE10-1Н дополнительный материал:

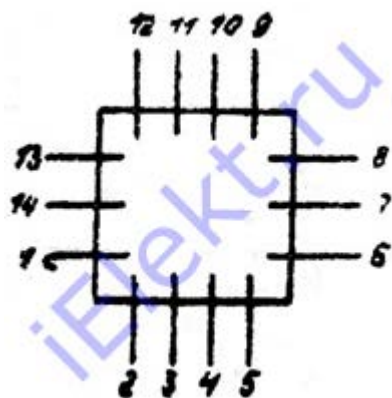
карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	логическая схема
таблица истинности	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов

Отсчет выводов вести против хода часовой стрелки. Первый вывод микросхемы загнут и находится между вторым и последним номерами тары сопроводительной.



Вес не превышает 0,015g

Графическое условное обозначение микросхемы

Таблица истинности

Назначение выводов

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основные 765IE10-1Н электро параметры:

Название характеристики, режим и единица замера	Обозначение буквой	Норма	
		меньше	больше
Ток потребления в состоянии логического нуля и логической единицы, μA ($U_{cc}=10V, U_{1vx}=10V, U_{0vx}=0$)	$I_{пот}$	-	0,50
Время задержки распространения при включении, ns ($U_{cc}=10V, U_{1vx}=10V, U_{0vx}=0, C=50pF$)	$t_{1,0зад.}$	-	50
Время задержки распространения при выключении, ns ($U_{cc}=10V, U_{1vx}=10V, U_{0vx}=0, C=50pF$)	$t_{0,1зад.}$	-	90
Выходное напряжение логического нуля, V ($U_{cc}=10V, U_{1vx}=10V, U_{0vx}=0$)	$U_{0вых}$	-	0,01
Выходное напряжение логической единицы, V ($U_{cc}=10V, U_{1vx}=10V, U_{0vx}=0$)	$U_{1вых}$	9,99	-

Указания по эксплуатации

указания по 765IE10-1Н эксплуатации:

1	Указания по применению и эксплуатации по ОСТ В 11.073.067-82, ОСТ 11.073.062-84 и БК0.347.151 ТУ.
2	До монтажа микросхем в ГС необходимо разводку контактных шин ПИТАНИЯ и ОБЩИЙ на плате РЭД соединить электрически между собой. При монтаже необходимо соблюдать следующую последовательность: вначале присоединяется вывод микросхемы ОБЩИЙ, а затем ПИТАНИЕ, потом остальные выводы.
3	Категорически запрещается эксплуатация микросхем в составе не герметичных модулей, корпусов и т.д.
4	При монтаже должны быть приняты меры, исключающие нагрев кристалла с защитным покрытием выше +85оС.
5	При монтаже микросхем в ГС не разрешается изгиб выводов ближе, чем на 0,3mm по длине вывода от места выхода из защитного покрытия и перегиб на инструменте с острыми краями.

	Не допускается пережатие (расплющивание) выводов.
6	Очередность подачи напряжений на микросхемы 765IE10-1H следующая: -напряжение питания; -входное напряжение. Очередность снятия напряжения: -входное напряжение; -напряжение питания.
7	Свободные выходы микросхем должны быть соединены с одной из шин питания.
8	Для крепления микросхем необходимо использовать составы, не растворяющие защитное покрытие микросхемы. При монтаже микросхем в герметизированную гибридную микросхему не допускается наличие внутри корпуса микросхемы паров этилового спирта, дибутилфтолата, этилцеллозольва, полиэтиленполиамин и других веществ, разрушающих покрытие микросхем.
9	Рекомендуется дополнительная просушка гибридной микросхемы пред герметизацией, при температуре меньше 85оС.
10	Выводы микросхем 765IE10-1H при монтаже рекомендуется подсоединять сваркой. Время теплового импульса меньше 0,2s с интервалом больше 0,5s. Температура жала паяльника не должна превышать 265оС.
11	Допускается значение электростатического потенциала меньше 100V.
12	При эксплуатации и изменении электропараметров с целью исключения влияния измерительных устройств на результаты измерения, допускается одновременно совмещать все уровни входных и питающих напряжений на одинаковую величину, сохраняя разность потенциалов между выводами микросхем.
13	Допускается случайное превышения импульса напряжения управляющего входа над напряжением питания на одном выводе меньше 1V при длительности импульса на уровне 0,5V меньше 1us и скважности больше 2.
14	Допускается случайный отрицательный импульс управляющего входа на одном (любом) выводе меньше 1V при длительности импульса на уровне 0,5 меньше 1us и скважности больше 2.
15	Неиспользуемые входы (выходы) микросхемы 765IE10-1H соединить с выводом ОБЩИЙ или Ucc

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
 Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадыр, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.